

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 504НТ1АСВК, 504НТ1БСВК, 504НТ1ВСВК, 504НТ1АС1ВК, 504НТ1БС1ВК, 504НТ1ВС1ВК соответствуют техническим условиям АЕЯР.431410.179 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № _____ от _____
Дата

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена _____
Дата

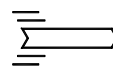
Приняты по извещению № _____ от _____
Дата

Штамп ОТК Штамп представителя заказчика

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ВНИМАНИЕ-Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ».

Допустимое значение статического потенциала 200 В.



МИКРОСХЕМЫ 504НТ1АСВК,
504НТ1БСВК, 504НТ1ВСВК,
504НТ1АС1ВК, 504НТ1БС1ВК, 504НТ1ВС1ВК

Код ОКП : 6331320385 – 504НТ1АСВК 6331320395 – 504НТ1АС1ВК
6331320405 – 504НТ1БСВК 6331320415 – 504НТ1БС1ВК
6331320425 – 504НТ1ВСВК 6331320435 – 504НТ1ВС1ВК

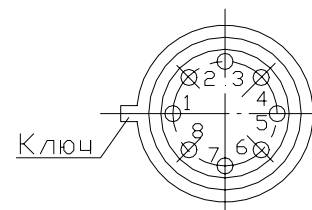
ЭТИКЕТКА

ЛСАР.431130.029 ЭТ

Микросхемы интегральные 504НТ1АСВК, 504НТ1БСВК, 504НТ1ВСВК, 504НТ1АС1ВК, 504НТ1БС1ВК, 504НТ1ВС1ВК – слаботочная согласованная пара полевых транзисторов.

Шифр кода маркировки микросхем 504НТ1АСВК, 504НТ1АС1ВК – 504НТ1А, 504НТ1БСВК, 504НТ1БС1ВК – 504НТ1Б, 504НТ1ВСВК, 504НТ1ВС1ВК – 504НТ1В в соответствии с АЕЯР.431410.179 ТУ.

Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно.

Ключ показывает начало отсчета выводов.

Масса не более 1,5 г.

Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Назначение вывода
1	Сток 1
2	Исток 1
3	Корпус
4	Исток 2
5	Сток 2
6	Затвор 2
7	Свободный
8	Затвор 1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при температуре (25 ± 5)° C							
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а					
		504НТ1АСВК 504НТ1АС1ВК		504НТ1БСВК 504НТ1БС1ВК		504НТ1ВСВК 504НТ1ВС1ВК	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Начальный ток стока, мА, при: U _{СИ} = -10 В; U _{ЗИ} = 0 В	I _{с.нач.}	0,1	0,7	0,4	1,5	0,7	2
Крутизна характеристики, мА/В, при: U _{СИ} = -10 В; U _{ЗИ} = 0 В	S	0,3	-	0,5	-	0,7	-
Ток утечки затвора, нА, при: U _{ЗИ} = 5 В;	I _{з.ут.}	-	2	-	2	-	2
Коэффициент шума, дБ, при: 1/F = 135 ± 45 Гц; U _{СИ} = -5 В; U _{ЗИ} = 0 В; R _Г = 1 МОм; F = 1 кГц	Кш	-	2	-	2	-	2
Разность напряжений затвористок, мВ, при: U _{СЗ} = -5 В; R _Н = 10 кОм; I _с = 100 мкА	U _{ЗИ1} - U _{ЗИ2}	-	30	-	30	-	30
Содержание драгоценных металлов в 1000 штук микросхем 504НТ1АС1ВК, 504НТ1БС1ВК, 504НТ1ВС1ВК: - золото В микросхемах 504НТ1АСВК, 504НТ1БСВК, 504НТ1ВСВК драгоценных металлов не содержится. Цветных металлов не содержится.							

<p>НАДЕЖНОСТЬ</p> <p>Минимальная наработка (Т_{нм}) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в облегченном режиме при напряжениях и токах, не превышающих 60% предельных значений, -150000ч</p> <p>Гамма-процентный ресурс (Т_{ру}) микросхем при у=95% 150000 ч</p> <p>Минимальный срок сохраняемости микросхем (Т_{см}) при их хранении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет; - в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет; - под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет. <p>Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.</p> <p>ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ</p> <p>Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431410.179 ТУ в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.</p> <p>Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.</p>
